

МОЩНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ N-P-N ТРАНЗИСТОРЫ

Мощные высоковольтные N-P-N кремниевые транзисторы серии ЛПир¹ и составные транзисторы (транзисторы Дарлингтона) серии ЛПилон¹ в пластмассовых корпусах ТО-218, ТО-220 предназначены для использования в быстродействующих схемах переключения с индуктивной нагрузкой, в импульсных схемах, схемах усилителей мощности с высокой линейностью и других электротехнических устройствах. Основные области применения:

- Регуляторы и преобразователи напряжения, в том числе специальные автомобильные и тракторные регуляторы напряжения
- Усилители мощности для высококачественной аудиоаппаратуры
- Импульсные источники питания и переключающие устройства
- Электронные системы зажигания

Серия	Тип транзистора	V _{СВО} (В)	V _{СЕО} (В)	V _{ЕВО} (В)	I _{Сmax} (А)	I _{Вmax} (А)	P _D (Вт)	h _{21FEmin}	V _{CE sat} (В)	Режим измерения V _{CE sat}	Тип корпуса
Пир	Пир-1	850	450	5	20	5	125	8	1.3	I _C =8 А, I _B =1.6 А	КТ43В-1В (ТО-218)
	КТ740А	200	160	5	20	5	125	30	1.0 2.5	I _C =8 А, I _B =0.8 А I _C =16 А, I _B =1.6 А	КТ43В-1В (ТО-218)
	КТ740Б	200	160	5	20	5	60	30	1.0 2.5	I _C =8 А, I _B =0.8 А I _C =16 А, I _B =1.6 А	КТ28(ТО-220)
	Пир-3А	190	40	5	15	1.5	50	100	0.3 0.5 0.8	I _C =5 А, I _B =0.5 А I _C =10 А, I _B =1.0 А I _C =15 А, I _B =1.5 А	КТ28(ТО-220)
	Пир-3Б	190	80	5	15	1.5	50	100	0.3 0.5 0.8	I _C =5 А, I _B =0.5 А I _C =10 А, I _B =1.0 А I _C =15 А, I _B =1.5 А	КТ28(ТО-220)
Пилон	Пилон-3	100	100	5	15	0.5	60	1000	1.5 1.7 2.5	I _C =3 А, I _B =12 мА I _C =5 А, I _B =20 мА I _C =10 А, I _B =20 мА	КТ28(ТО-220)
	КТ8246А	100	100	5	15	1.5	60	0.95	0.95	I _C =5 А, I _B =12 мА	КТ28(ТО-220)
	КТ8246Б	120	120	5	15	1.5	60	1000	1.0	I _C =5 А, I _B =12 мА	КТ28(ТО-220)
	КТ8246В	160	150	5	15	1.5	60	1000	1.2 1.25	I _C =5 А, I _B =12 мА I _C =5 А, I _B =5 мА	КТ28(ТО-220)
	КТ8246Г	300	150	5	15	1.5	60	750	1.3	I _C =5 А, I _B =12 мА	КТ28(ТО-220)
	КТ8232А	350-500	350-500	5	20	3	125	300	1.8 1.8	I _C =8 А, I _B =0.1 А I _C =10 А, I _B =0.25 А	КТ43В-1В (ТО-218)
	КТ8232Б	300-400	300-400	5	20	3	125	300	1.8 1.8	I _C =8 А, I _B =0.1 А I _C =10 А, I _B =0.25 А	КТ43В-1В (ТО-218)



Примечание:

1. Транзисторы КТ8232 А, Б имеет встроенную схему защиты от вторичного пробоя на основе диода Зенера. Типовое значение энергии вторичного пробоя $E=1$ Дж.
2. Возможна поставка транзисторов в металло-стеклянном корпусе [ТО-3 \(КТ9\)](#)